

Revendicări:

Fotodiodă quadrant selectivă, ce constă din substratul semiconductor InP, stratul activ $\text{In}_{x_1}\text{Ga}_{1-x_1}\text{As}_{y_1}\text{P}_{1-y_1}$, stratul frontal $\text{In}_{x_2}\text{Ga}_{1-x_2}\text{As}_{y_2}\text{P}_{1-y_2}$, contacte metalice pe partea din spate și cea frontală, cu suprafața divizată în patru fotoelemente sub formă de sector de cerc și un inel de gardă periferic circular, **caracterizată prin aceea că** în centru este confecționat un fotodetector electric izolat, cu raportul dintre diametrul detectorului central și diametrul quadrantului mai mic ca 1:10.